

Curriculum vitae

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Прізвище, ім'я, по батькові Оліх Олег Ярославович
Дата народження 05.06.1974
Громадянство Україна
E-mail olikh@univ.kiev.ua
Мобільний телефон +380673169020

ОСВІТА

1996-2000 аспірантура при кафедрі загальної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1991-1996 фізичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка, присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Фізик. Викладач» за спеціальністю фізика твердого тіла (диплом ЛТ ВЕ №001760, 28.06.1996)

НАУКОВІ СТУПЕНІ, ВЧЕНІ ЗВАННЯ

2018 захист дисертації «Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-галієвих структурах» на здобуття наукового ступеню доктора фізико-математичних наук за спеціальністю фізика твердого тіла (диплом ДД №008094, 18.12.2018)
2004 присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної фізики (атестат ДЦ №009574, 16.12.2004)
2001 захист дисертації «Дослідження акусто-фото-електричної взаємодії в напівпровідникових структурах GaAs і Si» на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю фізика твердого тіла (диплом ДК №010707, 16.05.2001)

ДОСВІД РОБОТИ

2002 - по сьогодні доцент кафедри загальної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1998-2002 асистент кафедри загальної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗНАННЯ МОВ

українська - С2
російська – С2
англійська – В2.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кількість наукових публікацій 74

Основні напрямки наукової діяльності Галузь знань «Природничі науки»
- вплив ультразвуку на речовину;
- використання ультразвукових методів для визначення параметрів напівпровідникових структур;
- акустостимульовані динамічні явища в напівпровідникових бар'єрних структурах

Публікації за період 2010–2020 рр. у періодичних виданнях, віднесених до першого та другого квартилів

1. Olikh Ya. M., Tymochko M. D., Olikh O.Ya. «Mechanisms of two-stage conductivity relaxation in CdTe:Cl with ultrasound», Journal of Electronic Materials, 2020, <https://doi.org/10.1007/s11664-020-08179-7>
2. Gorb A.M., Korotchenkov O.A., Olikh O.Ya., Podolian A.O., Chupryna R.G. «Influence of γ -irradiation and ultrasound treatment on current mechanism in Au-SiO₂-Si structure», Solid State Electronics, 2020, vol.165, 107712; <https://doi.org/10.1016/j.sse.2019.107712>
3. Olikh O.Ya. «Relationship between the ideality factor and the iron concentration in silicon solar cells», Superlattices and Microstructures, 2019, vol.136, 106309; <https://doi.org/10.1016/j.spmi.2019.106309>
4. Olikh Ya. M., Tymochko M. D., Olikh O.Ya., Shenderovsky V. A. «Clusters of point defects near dislocations as a tool to control CdZnTe electrical parameters by ultrasound», Journal of Electronic Materials, 2018, vol.47, is.8, P. 4370-4378; <https://doi.org/10.1007/s11664-018-6332-4>
5. Olikh O.Ya. «Acoustically driven degradation in single crystalline silicon solar cell», Superlattices and Microstructures, 2018, vol.117, p. 173-188; <https://doi.org/10.1016/j.spmi.2018.03.027>
6. Olikh O.Ya., Gorb A.M., Chupryna R.G., Pristay-Fenenkov O.V. «Acousto-defect interaction in irradiated and non-irradiated silicon n⁺-p structures», Journal of Applied Physics, 2018, vol.123, is.16, 161573; <https://doi.org/10.1063/1.5001123>
7. Olikh O.Ya., Voytenko K.V. «On the mechanism of ultrasonic loading effect in silicon-based Schottky diodes», Ultrasonics, 2016, vol.66, p. 1-3; <https://doi.org/10.1016/j.ultras.2015.12.001>
8. Olikh O.Ya. «Review and test of methods for determination of the Schottky diode parameters», Journal of Applied Physics, 2015, vol.118, is.2, 024502; <https://doi.org/10.1063/1.4926420>
9. Olikh O.Ya., Voytenko K.V., Burbelo R.M. «Ultrasound influence on I-V-T characteristics of silicon Schottky barrier structure», Journal of Applied Physics, 2015, vol.117, is.4, 044505; <https://doi.org/10.1063/1.4906844>
10. Olikh O.Ya. «Reversible influence of ultrasound on γ -irradiated Mo/n-Si Schottky barrier structure», Ultrasonics, 2015, vol.56, p. 545-550; <https://doi.org/10.1016/j.ultras.2014.10.008>
11. Olikh O.Ya. «Non-Monotonic γ -Ray Influence on Mo/n-Si Schottky Barrier Structure Properties», , IEEE Transactions on Nuclear Science, 2013, vol.60, is.1, part 2, p.394-401; <https://doi.org/10.1109/TNS.2012.2234137>
12. Gorb A.M., Korotchenkov O. A., Olikh O.Ya., Podolian A.O. «Ultrasonically Recovered Performance of γ -Irradiated Metal-Silicon Structures», IEEE Transactions on Nuclear Science, 2010, vol.57, is.3, p.1632-1639; <https://doi.org/10.1109/TNS.2010.2047655>

Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

First Name, Surname	Oleg Olikh
Date of Birth	05.06.1974
Citizenship	Ukraine
E-mail	olikh@univ.kiev.ua
Mobile Telephone	+380673169020

EDUCATION

1996-2000	Post-graduate course at the general physics department in Taras Shevchenko National University of Kyiv
1991-1996	Physics faculty of Taras Shevchenko University of Kyiv, master in solid state physics (diploma JIT BE №001760, 28.06.1996)

ACADEMIC DEGREE, ACADEMIC RANK

2018	Doctor of Science Degree (Physics and Mathematics), solid state physics specialty, thesis «Acoustically and radiation induced phenomena in surface barrier silicon and gallium arsenide structures» (diploma DD №008094, 18.12.2018)
2004	Academic rank of associate professor at the general physics department (diploma ДІІ №009574, 16.12.2004)
2001	PhD Degree (Physics and Mathematics), solid state physics specialty, thesis «Investigation of acousto-photo-electric interaction in GaAs and Si semiconductor structures» (diploma ДК №010707,)

WORK EXPERIENCE

2002 - Present	Associate professor at the general physics department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)
1998-2002	Assistant at the general physics department Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (Ukraine)

LANGUAGES

Ukrainian - C2
Russian – C2
English – B2.

SCIENTIFIC ACTIVITY

Number of Scientific Papers 74

Main Line of Investigation Field of knowledge "Nature Sciences"
- the ultrasound effect on materials;
- using of ultrasound methods to determine the semiconductor structure parameters;
acousto-stimulated dynamic phenomena in semiconductor barrier structures

Papers in Q1 and Q2 Journals (2010–2020)

1. Olikh Ya. M., Tymochko M. D., Olikh O.Ya. «Mechanisms of two-stage conductivity relaxation in CdTe:Cl with ultrasound», Journal of Electronic Materials, 2020, <https://doi.org/10.1007/s11664-020-08179-7>
2. Gorb A.M., Korotchenkov O.A., Olikh O.Ya., Podolian A.O.,

- Chupryna R.G. «Influence of γ -irradiation and ultrasound treatment on current mechanism in Au-SiO₂-Si structure», Solid State Electronics, 2020, vol.165, 107712; <https://doi.org/10.1016/j.sse.2019.107712>
3. Olikh O.Ya. «Relationship between the ideality factor and the iron concentration in silicon solar cells», Superlattices and Microstructures, 2019, vol.136, 106309; <https://doi.org/10.1016/j.spmi.2019.106309>
 4. Olikh Ya. M., Tymochko M. D., Olikh O.Ya., Shenderovsky V. A. «Clusters of point defects near dislocations as a tool to control CdZnTe electrical parameters by ultrasound», Journal of Electronic Materials, 2018, vol.47, is.8, P. 4370-4378; <https://doi.org/10.1007/s11664-018-6332-4>
 5. Olikh O.Ya. «Acoustically driven degradation in single crystalline silicon solar cell», Superlattices and Microstructures, 2018, vol.117, p. 173-188; <https://doi.org/10.1016/j.spmi.2018.03.027>
 6. Olikh O.Ya., Gorb A.M., Chupryna R.G., Pristay-Fenenkov O.V. «Acousto-defect interaction in irradiated and non-irradiated silicon n⁺-p structures», Journal of Applied Physics, 2018, vol.123, is.16, 161573; <https://doi.org/10.1063/1.5001123>
 7. Olikh O.Ya., Voytenko K.V. «On the mechanism of ultrasonic loading effect in silicon-based Schottky diodes», Ultrasonics, 2016, vol.66, p. 1-3; <https://doi.org/10.1016/j.ultras.2015.12.001>
 8. Olikh O.Ya. «Review and test of methods for determination of the Schottky diode parameters», Journal of Applied Physics, 2015, vol.118, is.2, 024502; <https://doi.org/10.1063/1.4926420>
 9. Olikh O.Ya., Voytenko K.V., Burbelo R.M. «Ultrasound influence on I-V-T characteristics of silicon Schottky barrier structure», Journal of Applied Physics, 2015, vol.117, is.4, 044505; <https://doi.org/10.1063/1.4906844>
 10. Olikh O.Ya. «Reversible influence of ultrasound on γ -irradiated Mo/n-Si Schottky barrier structure», Ultrasonics, 2015, vol.56, p. 545-550; <https://doi.org/10.1016/j.ultras.2014.10.008>
 11. Olikh O.Ya. «Non-Monotonic γ -Ray Influence on Mo/n-Si Schottky Barrier Structure Properties», , IEEE Transactions on Nuclear Science, 2013, vol.60, is.1, part 2, p.394-401; <https://doi.org/10.1109/TNS.2012.2234137>
 12. Gorb A.M., Korotchenkov O. A., Olikh O.Ya., Podolian A.O. «Ultrasonically Recovered Performance of γ -Irradiated Metal-Silicon Structures», IEEE Transactions on Nuclear Science, 2010, vol.57, is.3, p.1632-1639; <https://doi.org/10.1109/TNS.2010.2047655>